



Лист технической информации

Фоторезист AZ ECI 3000





Общие сведения

Серия фоторезистов AZ ECI 3000 – это семейство быстрых позитивных резистов с высоким разрешением (контролируемый размер 0,4 мкм при производстве с помощью і-линии), которые обеспечивает значительную технологическую широту. Семейство резистов подходит для экспонирования с помощью і-линии, а также для экспонирования полным спектром ртутной лампы, охватывающего длины волн освещения g-, h- и і-линии. Оно разработано для обеспечения превосходной стойкости к имплантации и сухому травлению. Дополнительные характеристики демонстрируют сильную адгезию при влажном травлении и хорошую термическую стабильность. Серия фоторезистов AZ® ECI 3000 специально разработана для универсального применения и отличается превосходной стоимостью.

Рекомендуемый процесс

Сушка:	90°C, 60 с (с контактом) – 90 с (с зазором)
Экспонирование	экспонирование с помощью степпера i- и g-линии или экспонирование полным спектром ртутной лампы
Термообработка после экспонирования:	110 °C, 60 с (с контактом) – 90 с (с зазором)
Проявление:	60 с, под слоем жидкости, проявитель AZ 300 MIF (без ПАВ) или AZ 726 (с ПАВ)

Вязкость

Подходящие вспомогательные вещества

Верхнее антиотражающее покрытие AZ Aquatar VIII-A AZ ECI 3007 \sim 0,6–1,3 мкм FT Нижнее антиотражающее покрытие AZ BARLi II AZ ECI 3012 \sim 1,1–2,4 мкм FT Удалитель краевого валика AZ EBR 70/30 AZ ECI 3027 \sim 2,2–5 мкм FT

Сниматель AZ 100 или AZ 400T

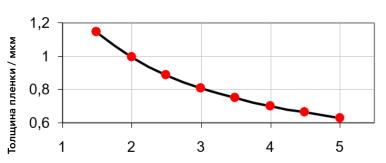


AZ ECI 3000

Фоторезист AZ ECI 3007

Кривая нанесения

Сушка: 90 °C, 60 с, с зазором Размер пластины: 6" (150 мм) динамическое дозирование



Скорость вращения центрифуги / тыс. об/мин

Толщина пленки	2000 об/мин	3000 об/мин	4000 об/мин	5000 об/мин
	0,99 мкм	0,81 мкм	0,70 мкм	0,63 мкм

Перекрытие тонких пленок в і-линии

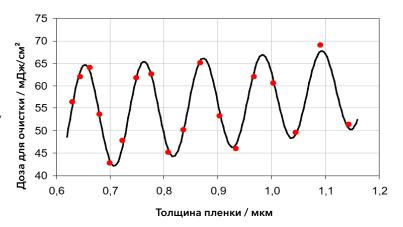
(на кремнии без покрытия) Сушка: 90°C, 60 с, с зазором Экспонирование: степпер і-линии

Nikon NSR-1755i7B 0,54 NA, 0,6 c

Термообработка после экспонирования: 110 °C, 60 с, с зазором

Проявление: 60 с, под слоем жидкости, 23 °C

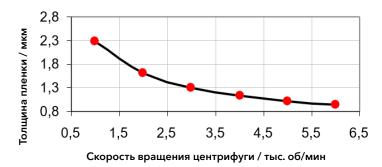
проявитель AZ 726 MIF



Фоторезист AZ ECI 3012

Кривая нанесения

Сушка: 90 °C, 90 с, с зазором Размер пластины: 6" (150 мм) динамическое дозирование



Толщина пленки	2000 об/мин	3000 об/мин	4000 об/мин	5000 об/мин
	1,61 мкм	1,31 мкм	1,13 мкм	1,02 мкм
	1,2 нм	0,8 нм	0,5 нм	1,1 нм





AZ ECI 3000

Перекрытие тонких пленок в і-линии

(на кремнии без покрытия)

Сушка: 90 °C, 90 с, с зазором Экспонирование: степпер і-линии

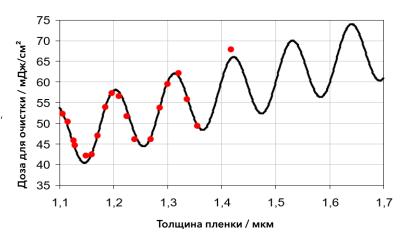
Nikon NSR-1755i7B 0,54 NA, 0,6 c

Термообработка после экспонирования: 110 °C,

90 с, с зазором

Проявление: 60 с, под слоем жидкости, 23 °C

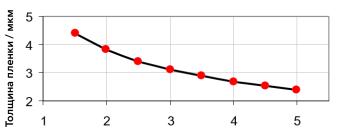
проявитель AZ 300 MIF



Фоторезист AZ ECI 3012

Кривая нанесения

Сушка: 90 °C, 60 с, с зазором Размер пластины: 6" (150 мм) динамическое дозирование



Скорость вращения центрифуги / тыс. об/мин

Толщина пленки	2000 об/мин	3000 об/мин	4000 об/мин	5000 об/мин
	3,80 мкм	3,11 мкм	2,69 мкм	2,41 мкм

Перекрытие тонких пленок в і-линии

(на кремнии без покрытия)

Сушка: 90 °C, 60 с, с зазором

Экспонирование: степпер і-линии

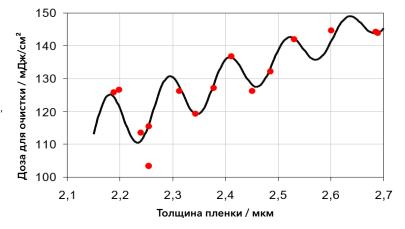
Nikon NSR-1755i7B 0,54 NA, 0,6 c

Термообработка после экспонирования: 110 °C,

60 с, с зазором

Проявление: 60 с, под слоем жидкости, 23 °C

проявитель AZ 726 MIF







Нанесение фоторезиста AZ ECI 3007 на кремниевую подложку без покрытия

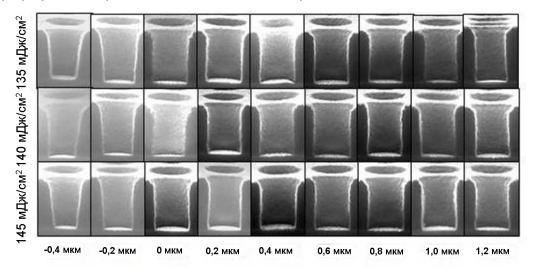
Сушка: 90°C, 90 с, с зазором Толщина пленки 0,763 мкм Етах

Экспонирование: степпер і-линии Nikon NSR-1755i7B 0,54 NA, 0,6 с Термообработка после экспонирования: 110 °C, 90 с, с зазором Проявление: 60 с, под слоем жидкости, проявитель AZ 300 MIF, 23 °C

Контролируемый размер 0,5 мкм, отверстия для контакта с малым зазором, обобщенное технологическое окно в лучшей

точке: 140 мДж/см², глубина фокусировки 1,37 мкм, широта экспонирования 29,1 %

Широта фокусировки отверстия для контакта с малым зазором 0,5 мкм



Фоторезист AZ ECI 3012

Линейность

(линии с малым зазором на кремнии без покрытия)

Сушка: 90°С, 90 с, с зазором Толщина пленки: 1,2 мкм, Emax Экспонирование: степпер i-линии

Nikon NSR-1755i7B 0,54 NA, 0,6 c

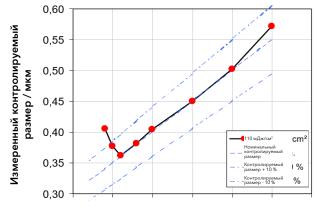
Термообработка после экспонирования: 110 °C,

90 с, с зазором

Проявление: 60 с, под слоем жидкости, 23 °C

проявитель AZ 300 MIF

Измерение: Hitachi S-8840 CD SEM



Номинальный контролируемый размер / мкм





Нанесение покрытия на кремниевую подложку без покрытия

Сушка: 90 °C, 90 с, с зазором Толщина пленки 1,2 мкм

Экспонирование: степпер і-линии Nikon NSR-1755i7B, 0,54 NA, 0,6 с Термообработка после экспонирования: 110 °C, 90 с, с зазором Проявление: 60 с, под слоем жидкости, проявитель AZ 300 MIF, 23 °C

Линейность линии с малым зазором, 110 мДж/см²













Широта фокусировки линии с малым зазором 0,4 мкм, 110 мДж/см²













Линейность отверстия для контакта с малым зазором, 136 мДж/см 2













Широта фокусировки отверстия для контакта с малым зазором 0,6 мкм, 136 мДж/см²

















Фоторезист AZ ECI 3027

Линейность

(линии с малым зазором на кремнии без

покрытия)

Сушка: 100°C, 60 с, с зазором Толщина пленки: 2,5 мкм

Экспонирование: степпер і-линии

Nikon NSR-1755i7B 0,54 NA, 0,6 c

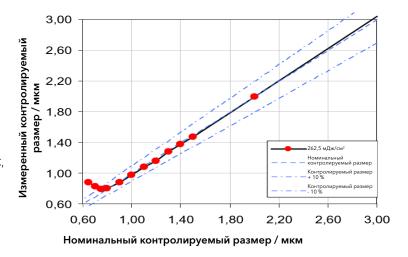
Термообработка после экспонирования: 120 °C,

60 с, с зазором

Проявление: 60 с, под слоем жидкости, 23 °C

проявитель AZ 726 MIF

Измерение: Hitachi S-8840 CD SEM



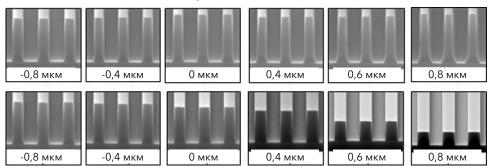
Нанесение покрытия на кремниевую подложку без покрытия

Сушка: 100 °C, 60 с, с зазором Толщина пленки 2,5 мкм

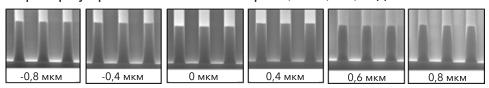
Экспонирование: степпер і-линии Nikon NSR-1755і7В, 0,54 NA, 0,6 с Термообработка после экспонирования: 120 °C, 60 с, с зазором Проявление: 60 с, под слоем жидкости, проявитель AZ® 726 MIF, 23 °C

Контролируемый размер 1,3 мкм, линии с малым зазором, обобщенное технологическое окно в лучшей точке: 270 мДж/см², глубина фокусировки 1,3 мкм, широта экспонирования 32,4 %

Линейность линии с малым зазором, 262,5 мДж/см²



Широта фокусировки линии с малым зазором 1,3 мкм, 262,5 мДж/см²







Фоторезист AZ ECI 3012

Термическая стабильность

край 100 мкм, толщина пленки 1,2 мкм, контактное задубливание в течение 60 с

Сушка: 90 °C, 90 с, с зазором

Экспонирование: степпер і-линии Nikon NSR-1755i7B, 0,54 NA, 0,6 с Термообработка после экспонирования: 110°C, 90 с, с зазором Проявление: 60 с, под слоем жидкости, проявитель AZ® 300 MIF, 23°C













Широта экспонирования полным спектром ртутной лампы

линии 3 мкм, толщина пленки 1,2 мкм

Сушка: 90 °C, 60 с, с контактом

Экспонирование: установка совмещения и проекционного экспонирования серии Perkin Elmer 340, диафрагма: 1,

ширина щели: 1 мм

Термообработка после экспонирования: 110 °C, 60 с, с контактом Проявление: 60 с, под слоем жидкости, проявитель AZ 300 MIF, 23 °C















Глубина фокусировки / широта экспонирования линии 3 мкм

(установка серии Perkin Elmer 340)

Подложка: Кремний

Сушка: 90 °C, 60 с, с контактом Толщина пленки: 1,2 мкм

Экспонирование: Perkin Elmer 340

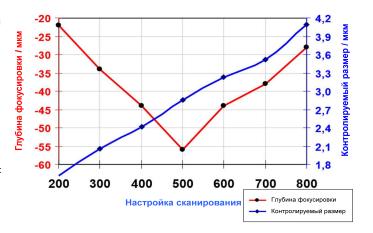
Диафрагма: 1 Ширина щели: 1 мм

Термообработка после экспонирования: 110 °C, 60 с, с

контактом

Проявление: 60 с, под слоем жидкости, 23 $^{\circ}$ С

проявитель AZ 300 MIF

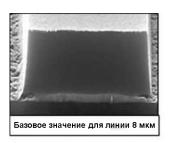


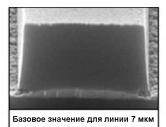
Адгезия к ІТО

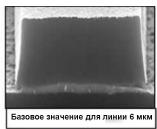
Сушка: 90 °C, 90 с, с зазором Толщина пленки 1,7 мкм

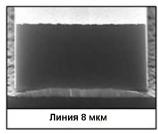
Экспонирование: степпер і-линии Nikon NSR-1755і7В, 0,54 NA, 0,6 с Термообработка после экспонирования: 110 °C, 90 с, с зазором Проявление: 60 с, под слоем жидкости, проявитель AZ® 300 MIF, 23 °C

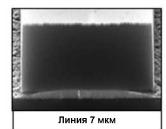
Травление ITO: продолжительность травления (70 c), погружение в FeCl3/HCl при 45 °C, толщина ITO: 200 нм

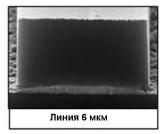














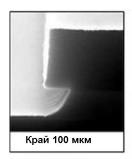
Адгезия к термически образованному оксиду

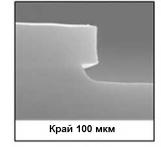
Толщина термически образованного оксида: 690 нм

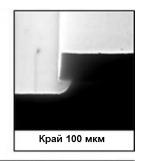
Праймер ГМДС, вакуум в течение 30 мин Толщина резиста: 1,33 на пластине 2" Сушка: 90°С, 60 с, с контактом Экспонирование: Suss MA 56

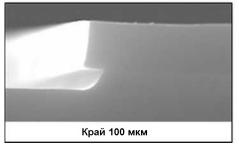
Термообработка после экспонирования: 110 °C, 60 с, с контактом Проявление: 60 с, погружение, проявитель AZ® 300 MIF, 23 °C

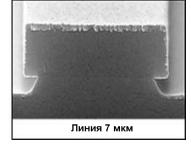
Раствор травления оксида: Merck AF 87,5-12,5, 22 °C Продолжительность травления оксида: 6 мин Остаточная толщина оксида после травления: 75 нм











Интерференция тонкой пленки, полученной с помощью і-линии (на кремнии без покрытия)

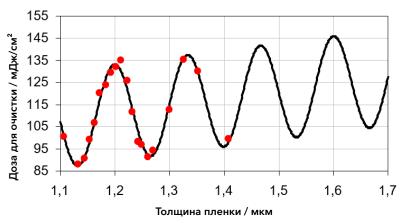
Сушка: 90 °C, 90 с, с зазором

Экспонирование: степпер д-линии

Nikon NSR-1505G7E 0,54 NA, 0,5 c

Термообработка после экспонирования: 110 °C, 90 с, с зазором

Проявление: 60 с, под слоем жидкости, 23 °C проявитель AZ 300 MIF







Линейность

(линии с малым зазором на кремнии без

покрытия)

Сушка: 90 °C, 90 с, с зазором Толщина пленки: 1,2 мкм, Етах Экспонирование: степпер д-линии

Nikon NSR-1505G7E 0,54 NA, 0,5 c

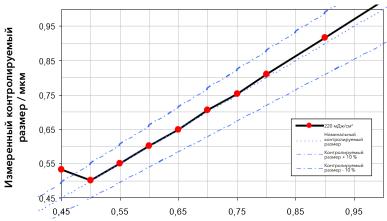
Термообработка после экспонирования:

110 °C, 90 с, с зазором

Проявление: 60 с, под слоем жидкости, 23 °C

проявитель AZ 300 MIF

Измерение: Hitachi S-8840 CD SEM



Номинальный контролируемый размер / мкм

Нанесение покрытия на кремниевую подложку без покрытия

Сушка: 90 °C, 90 с, с зазором Толщина пленки 1,2 мкм

Экспонирование: степпер g-линии Nikon NSR-1505G7E, 0,54 NA, 0,5 с Термообработка после экспонирования: 110 °C, 90 с, с зазором Проявление: 60 с, под слоем жидкости, проявитель AZ® 300 MIF, 23 °C

Линейность линии с малым зазором, 220 мДж/см²













Широта фокусировки линии с малым зазором 0,5 мкм, 220 мДж/см²

















Характеристики Ultratech 1500 на кремниевой подложке без покрытия

Сушка: 90°C, 90 с, с зазором Толщина пленки 1,2 мкм

Экспонирование: степпер Ultratech 1500 1X

Термообработка после экспонирования: 110 °C, 90 с, с зазором Проявление: 60 с, под слоем жидкости, проявитель AZ 300 MIF, 23 °C

Линейность линии с малым зазором, 180 мДж/см²











Широта фокусировки линии с малым зазором 1,0 мкм, 180 мДж/см²













Широта экспонирования линии с малым зазором 1,0 мкм













Коэффициенты Коши	Α	В	С
В неотбеленном состоянии	1,6018	0,0098963 мкм²	0,00068636 мкм ⁴
	1,6018	9,8963 x 105 Ų	6,8636 x 1012 Å⁴
В отбеленном состоянии	1,5952	0,0084508 мкм²	0,0006556 мкм⁴
	1,5952	8,4508 x 105 Ų	6,556 x 1012 Å⁴

Коэффициент преломления		365 нм	405 нм	435 нм	633 нм
В неотбеленном состоянии	n	1,7014	1,6803	1,6826	1,6308
	k	0,0202	0,0244	0,0166	0
В отбеленном состоянии	n	1,6913	1,6670	1,6530	1,6204
	k	0,0017	0,0010	0	0,0001

Параметры дилла	Α	В	С
і-линия	0,64 мкм-1	0,075 мкм-1	0,0159 см²/мДж
h-линия	0,76 мкм-1	0,035 мкм-1	0,0244 см²/мДж
д-линия	0,45 мкм-1	0,036 мкм-1	0,0152 см²/мДж

Мы консультируем наших клиентов в отношении технического применения в рамках своих знаний и имеющихся возможностей, но без каких-либо обязательств. Необходимо всегда соблюдать действующие законы и постановления. Это также относится к любым защищенным правам третьих лиц. Наши предложения не освобождают клиентов от необходимости тестировать нашу продукцию под свою ответственность на предмет пригодности для предполагаемой цели. Цитаты из нашей документации разрешены только с нашего письменного разрешения с указанием их источника.

Фоторезист AZ ECI 3000

Универсальная серия фоторезиста для і-линии/пересечения

